

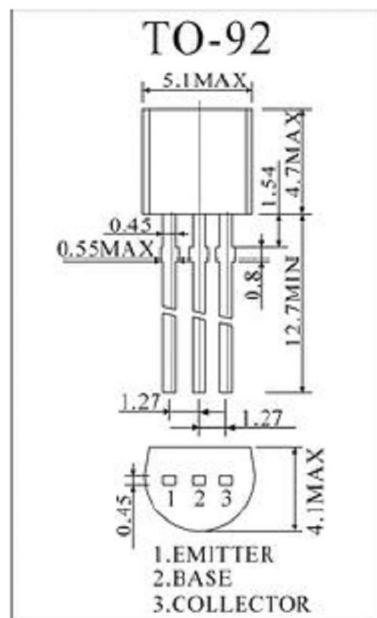
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

C945

—NPN silicon—

■绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CB0}	60	V
集电极—发射极电压	V _{CEO}	50	V
发射极—基极电压	V _{EB0}	5	V
集电极电流	I _c	0.15	A
集电极耗散功率	P _c	0.4	W
结 温	T _j	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C



■电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	70	200	400		V _{CE} = 6 V, I _c = 1 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			100	nA	V _{CB} = 60 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			100	nA	V _{EB} = 5 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	60			V	I _c = 0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	50			V	I _c = 0.1 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	5			V	I _E = 0.1mA, I _c =0
基极-发射极电压	V _{BE}		0.62		V	V _{CE} = 6 V, I _c = 1mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		0.15	0.3	V	I _c = 100 mA, I _B = 10 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}		0.86	1	V	I _c = 100 mA, I _B = 10 mA
电流增益-带宽乘积	f _r	150	250	450	MHz	I _c = 10 mA, V _{CE} = 6 V
共基极输出电容	C _{ob}		3.0	4.0	PF	V _{CB} = 6 V, I _E =0, f = 1 MHz
噪声系数	N _F		8	15	dB	V _{CE} =6V, I _c =0.1mA, f=1KHz, R _g =2K Ω

■h_{FE} 分档及其标志

分 档	O	Y	G
h _{FE}	70~140	120~240	200~400